

calculatoratoz.comunitsconverters.com

MOSFET-Eigenschaften Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute
Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 16 MOSFET-Eigenschaften Formeln

MOSFET-Eigenschaften ↗

1) Body-Effekt auf die Transkonduktanz ↗

fx $g_{mb} = X \cdot g_m$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.1\text{mS} = 0.2 \cdot 0.5\text{mS}$

2) Gate-Source-Kanalbreite des MOSFET ↗

fx $W_c = \frac{C_{oc}}{C_{ox} \cdot L_{ov}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $9.957028\mu\text{m} = \frac{3.8\text{e-}7\mu\text{F}}{940\mu\text{F} \cdot 40.6\mu\text{m}}$

3) Leitfähigkeit des Kanals des MOSFET unter Verwendung der Gate-Source-Spannung ↗

fx $G = \mu_s \cdot C_{ox} \cdot \frac{W_c}{L} \cdot (V_{gs} - V_{th})$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $6.0724\text{mS} = 38\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s} \cdot 940\mu\text{F} \cdot \frac{10\mu\text{m}}{100\mu\text{m}} \cdot (4\text{V} - 2.3\text{V})$



4) Leitfähigkeit im linearen Widerstand des MOSFET ↗

fx $G = \frac{1}{R_{ds}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $6.024096\text{mS} = \frac{1}{0.166\text{k}\Omega}$

5) Maximale Spannungsverstärkung am Vorspannungspunkt ↗

fx $A_{vm} = 2 \cdot \frac{V_{dd} - V_{eff}}{V_{eff}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $7.941176 = 2 \cdot \frac{8.45\text{V} - 1.7\text{V}}{1.7\text{V}}$

6) Maximale Spannungsverstärkung bei allen Spannungen ↗

fx $A_{vm} = \frac{V_{dd} - 0.3}{V_t}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $7.990196 = \frac{8.45\text{V} - 0.3}{1.02\text{V}}$

7) MOSFET-Transkonduktanz bei gegebener Oxidkapazität ↗

fx $g_m = \sqrt{2 \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W_t}{L_t} \right) \cdot I_d}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2.286578\text{S} = \sqrt{2 \cdot 30\text{m}^2/\text{V}^*\text{s} \cdot 3.9\text{F} \cdot \left(\frac{5.5\mu\text{m}}{3.2\mu\text{m}} \right) \cdot 0.013\text{A}}$



8) Sättigungsspannung des MOSFET ↗

fx $V_{ds(s)} = V_{gs} - V_{th}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $1.7V = 4V - 2.3V$

9) Schwellenspannung des MOSFET ↗

fx $V_{th} = V_{gs} - V_{eff}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2.3V = 4V - 1.7V$

10) Spannungsverstärkung bei gegebenem Lastwiderstand des MOSFET ↗

fx $A_v = g_m \cdot \frac{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{out}}}{1 + g_m \cdot R_s}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.026099 = 0.5mS \cdot \frac{\frac{1}{0.28k\Omega} + \frac{1}{4.5k\Omega}}{1 + 0.5mS \cdot 8.1k\Omega}$

11) Spannungsverstärkung bei gegebener Drain-Spannung ↗

fx $A_v = \frac{i_d \cdot R_L \cdot 2}{V_{eff}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.026353 = \frac{0.08mA \cdot 0.28k\Omega \cdot 2}{1.7V}$



12) Spannungsverstärkung mit Kleinsignal ↗

fx $A_v = g_m \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{fi}}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.026377 = 0.5\text{mS} \cdot \frac{1}{\frac{1}{0.28\text{k}\Omega} + \frac{1}{0.065\text{k}\Omega}}$

13) Transkonduktanz im MOSFET ↗

fx $g_m = \frac{2 \cdot i_d}{V_{ov}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $0.5\text{mS} = \frac{2 \cdot 0.08\text{mA}}{0.32\text{V}}$

14) Übergangsfrequenz des MOSFET ↗

fx $f_t = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot (C_{sg} + C_{gd})}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $5.249174\text{Hz} = \frac{0.5\text{mS}}{2 \cdot \pi \cdot (8.16\mu\text{F} + 7\mu\text{F})}$

15) Verstärkungsfaktor im Kleinsignal-MOSFET-Modell ↗

fx $A_f = g_m \cdot R_{out}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $2.25 = 0.5\text{mS} \cdot 4.5\text{k}\Omega$



16) Vorspannung des MOSFET ↗

fx $V_{be} = V_{bias} + V_{de}$

Rechner öffnen ↗

ex $8.3V = 5.3V + 3V$



Verwendete Variablen

- A_f Verstärkungsfaktor
- A_v Spannungsverstärkung
- A_{vm} Maximale Spannungsverstärkung
- C_{gd} Gate-Drain-Kapazität (Mikrofarad)
- C_{oc} Überlappungskapazität (Mikrofarad)
- C_{ox} Oxidkapazität (Mikrofarad)
- C_{ox} Oxidkapazität (Farad)
- C_{sg} Source-Gate-Kapazität (Mikrofarad)
- f_t Übergangsfrequenz (Hertz)
- G Leitfähigkeit des Kanals (Millisiemens)
- g_m Steilheit (Millisiemens)
- g_m Transkonduktanz im MOSFET (Siemens)
- g_{mb} Körpertranskonduktanz (Millisiemens)
- i_d Stromverbrauch (Milliampere)
- I_d Stromverbrauch (Ampere)
- L Kanallänge (Mikrometer)
- L_{ov} Überlappungslänge (Mikrometer)
- L_t Transistorlänge (Mikrometer)
- R_{ds} Linearer Widerstand (Kiloohm)
- R_{fi} Endlicher Widerstand (Kiloohm)
- R_L Lastwiderstand (Kiloohm)



- R_{out} Ausgangswiderstand (Kiloohm)
- R_s Quellenwiderstand (Kiloohm)
- V_{be} Gesamte momentane Vorspannung (Volt)
- V_{bias} DC-Vorspannung (Volt)
- V_{dd} Versorgungsspannung (Volt)
- V_{de} Gleichspannung (Volt)
- $V_{ds(s)}$ Drain- und Source-Sättigungsspannung (Volt)
- V_{eff} Effektive Spannung (Volt)
- V_{gs} Gate-Source-Spannung (Volt)
- V_{ov} Overdrive-Spannung (Volt)
- V_t Thermische Spannung (Volt)
- V_{th} Grenzspannung (Volt)
- W_c Kanalbreite (Mikrometer)
- W_t Breite des Transistors (Mikrometer)
- μ_n Elektronenmobilität (Quadratmeter pro Volt pro Sekunde)
- μ_s Mobilität von Elektronen an der Oberfläche des Kanals (Quadratmeter pro Volt pro Sekunde)
- X Änderung des Schwellenwerts zur Basisspannung



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes-Konstante
- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
- **Messung: Länge** in Mikrometer (μm)
Länge Einheitenumrechnung 
- **Messung: Elektrischer Strom** in Ampere (A), Milliampere (mA)
Elektrischer Strom Einheitenumrechnung 
- **Messung: Frequenz** in Hertz (Hz)
Frequenz Einheitenumrechnung 
- **Messung: Kapazität** in Mikrofarad (μF), Farad (F)
Kapazität Einheitenumrechnung 
- **Messung: Elektrischer Widerstand** in Kilohm ($\text{k}\Omega$)
Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung 
- **Messung: Elektrische Leitfähigkeit** in Millisiemens (mS), Siemens (S)
Elektrische Leitfähigkeit Einheitenumrechnung 
- **Messung: Elektrisches Potenzial** in Volt (V)
Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung 
- **Messung: Mobilität** in Quadratmeter pro Volt pro Sekunde ($\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Mobilität Einheitenumrechnung 



Überprüfen Sie andere Formellisten

- MOSFET-Eigenschaften

Formeln 

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/10/2024 | 9:34:05 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

